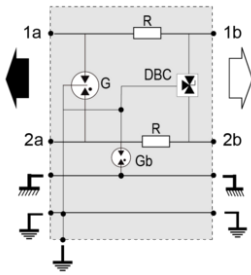




- Für alle MSR, Telekommunikations- und Datentechnik Anwendungen
- Monoblockgehäuse mit 1TE
- 1 Doppeladern geschützt
- Erdung über Hutschiene
- Erfüllt IEC 61643-21 und VDE 0845-3-1



G: 3-electrode gas tube
 Gb: 2-electrode gas tube
 R: Resistor
 D: Clamping diode

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung z.B. 230/400		6 V line, Hohe Datenrate, MIC/T2, 10BaseT
Nennspannung	Un	6 V
Höchste Dauerspannung DC	Uc	10 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	> 20 MHz
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	300 mA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	Imax	20 kA
Serieninduktivität		Keine
Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential		CM / DM
C3 Schutzpegel L/L @ In (8/20 µs)	Up L/L	25 V
max. Kapazität	C	< 50 pF
D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	Iimp	5 kA
C2 Nennableitstoßstrom 10x 8/20 µs Impulse	In	5 kA
Serienwiderstand		< 4.7 Ohm
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk
Ableiterkonfiguration		1 Doppelader + Schirm
Anschlussart		Anschluss der Adern über Schraubklemmen max. 2,5 mm ² Erdung über Hutschiene
Bauart		Monoblock-Gehäuse für Hutschiene montage
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Kurzschluss
Fehlersignalisierung		Unterbrechung der Übertragung
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497 A
Zulassungen		UL 497B
Artikel Nummer		
640511		

